講義ノート

# 焼結の基礎─理論的背景から実際まで─Ⅲ.多粒子系の焼結緻密化挙動

前回概観したような、焼結緻密化の基本的な(二粒子系な ど単純な幾何学モデルに基づき構築された)速度式は,1960 年代までに一通りの完成を見た. このアプローチで焼結挙動 を解析する場合,焼結過程の三段階(初期・中期・後期焼結) のうちの一つに注目し、実験的に得られる緻密化挙動と、そ の焼結段階で考え得る緻密化機構の速度式とを比較して、主 体となる(すなわち律速過程となる)緻密化機構が決定され る. また律速過程を既知とした上で, 焼結挙動を支配する各 れてきた. 実際, 原料粉末の粒子径や粒度分布といった幾何 学的条件が理想的なものであれば、焼結実験から各種焼結パ ラメータを評価することが可能である.だが実際にはほとん どの場合、粒子サイズや粒子形状、その充填などに無視でき ない分布が存在する. 原料粉末の粒子径や粒成長挙動, 原料 粉末の充填密度,成形体の形状,さらに焼結温度や昇温速度 といった各種焼結条件によって焼結挙動は大きく影響を受け る. さまざまな因子の下で、その材料がどのような焼結緻密 化挙動を示すのか、またどのような条件であれば緻密化が完 了するのかといった知見を得ることは実用上重要な課題とな る. さらに製品の形状や組織が複雑になると、焼結後に発生 する不均一なひずみや割れなどの欠陥を生じさせないよう な、焼結条件の最適化が必要になる.こうした問題に取り組 むには,基本的な緻密化速度式による解析では自ずと限界が あるため、二粒子間での物質輸送ではなく、多粒子系全体の 緻密化挙動を近似的に取り扱う試みが多数なされてきた.本 稿では、こうした立場から俯瞰的に焼結挙動を理解するため のアプローチについて概観する.

## 3・1 焼結ダイアグラム

### 3·1·1 常圧焼結

焼結緻密化速度式を用いれば、さまざまな粉末粒子径、焼

# 吉 田 英 弘\*

結温度等の条件に対して緻密化速度の理論値が得られる. *Ashby*<sup>(1)</sup>は古典的な二粒子モデルに基づき,焼結初期・中 期・後期段階のそれぞれで起こりうる各焼結機構に基づいた 焼結速度式から緻密化速度を求め,与えられた温度,粒子径 およびネック径に対するネックの成長速度を律速する最も支 配的な焼結機構を示した.これを焼結ダイアグラムと呼ぶ. 図3.1に,粒子径2µmのUO<sub>2</sub>について描かれた焼結ダイア グラムを示す<sup>(1)</sup>.図中,焼結初期・中期・後期段階をそれぞ れステージ1・2・3とし,加えて原料粉末粒子同士が接触 した瞬間に原子間力によってネック形成される段階(粒子の 凝着)をステージ0としている.

図3.1の横軸は材料の融点( $T_m$ )で規格化した温度,縦軸は 規格化されたネック半径(粒子半径に対するネック半径の比) をプロットしている.太線で区切られた領域内には,与えら れた温度・ネック径条件で最も速い焼結緻密化をもたらす焼 結機構が記載されている.図3.1に示すような,微細結晶粒 のセラミックスでは粒界拡散が支配的な焼結機構となる領域 が大きい.なお図中の細線は,等温保持で記載された時間が 経過した後のネックサイズを示しており,(当然ながら)温度 が高いほどより短時間でより大きなネック半径に到達するこ とが分かる.焼結ダイアグラムに記載されたこれらの情報を もとに,所望の微構造を有する焼結体を製造する方法を検討 することができる<sup>(1)</sup>.同様の整理は,金属から酸化物まで様 々な材料に対してなされている.

緻密化と同時に起こる粒成長も取り入れた焼結ダイアグラ ムも描かれている.例えば Kang と Jung は,粉末成形体に おける粒成長の影響を勘案して,焼結後期過程における粒界 拡散機構および体拡散機構の緻密化速度の理論曲線を与え た<sup>(2)</sup>.

焼結体の相対密度 ρ に対し、緻密化速度 dρ/dt はそれぞれの緻密化機構に対して以下の式で与えられる.

Keywords: sintering, powder, ceramics, high temperature, diffusion, densification, polycrystal, grain boundary 2019年5月7日受理[doi:10.2320/materia.58.782]

<sup>\*</sup> 東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻; 教授(〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1) Fundamentals of Sintering: Theory and Practice 一Ⅲ. Densification Behavior of Multi-particle Systems; Hidehiro Yoshida(School of Engineering, Department of Materials Science, The University of Tokyo, Tokyo)



図3.1 粒子径2µmのUO2の焼結ダイアグラム(1). 図中,原料粉末粒子同士が接触した瞬間に原子間力によってネック形成される段階(粒子の凝着)をステージ0とし,焼結初期・中期・後期段階をそれぞれステージ1・2・3としている.

(1) 体拡散機構

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = \frac{441 D_{\mathrm{l}} \gamma_{\mathrm{S}} \Omega}{RTG^3} (1-\rho)^{1/3} \tag{1}$$

ただし $D_1$ は体拡散係数, $\gamma_S$ は表面エネルギー, $\Omega$ は原子 (分子)体積,RTは気体定数と絶対温度の積,Gは粒径である.

(2) 粒界拡散機構

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = \frac{733\delta_{\mathrm{gb}}D_{\mathrm{gb}}\gamma_{\mathrm{S}}\Omega}{RTG^4} \tag{2}$$

ただし $\delta_{gb}$ は粒界幅, $D_{gb}$ は体拡散係数である.

一方,粒成長メカニズムとして表面拡散機構を仮定し,粒 成長速度を表面拡散係数と粒径および相対密度を用いて次の ように記述されるとした.

$$\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t} = \frac{110 D_{\mathrm{S}} \delta_{\mathrm{S}} \gamma_{\mathrm{gb}} \Omega}{RTG^3} (1-\rho)^{-4/3} \tag{3}$$

ただし $D_{\rm S}$ は表面拡散係数、 $\delta_{\rm S}$ は表面拡散の起こる表面厚さ、 $y_{\rm gb}$ は粒界エネルギーである.

図3.2(a)に、初期粒径の異なる Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>における、粒界拡散 および体拡散機構による緻密化曲線の計算値を示す.温度は 1650℃で一定としている.初期粒径0.7 µm の場合、粒界拡 散機構による緻密化(図3.2(a)の黒い実線)は体拡散機構のそ れ(図3.2(a)の灰色の実線)よりも非常に速やかに起こる.初 期粒径が2.4 µm(破線)、6 µm(一点破線)と粗大化すると共 に、焼結緻密化が著しく遅くなることが分かる.また、図の 焼結温度(1650℃)では、初期粒径0.7 µm および2.4 µm では 体拡散機構よりも粒界拡散機構がより速い緻密化をもたらし ているが、6 µm では体拡散機構がな界拡散機構よりも優勢 になることが分かる.この粒径依存性は、材料の単位体積当 たりの粒界面積が粒径の微細化と共に増加することから、定 性的にも妥当である.つまり焼結緻密化の律速機構は、同一 材料であっても原料粉末の粒径や焼結温度に依存して変化す



図3.2 (a) Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> における緻密化曲線の理論値. 焼結温 度は1650℃. (b) 融点で規格化した規格化温度 に対する相対密度をプロットした,異なる初期 粒径での焼結ダイアグラム.文献(2)の計算式に 基づき,計算は筆者による.初期粒径が微細で あるほど,粒界拡散機構が律速する領域が拡大 することが分かる.

る.図3.2(b)には,融点で規格化した規格化温度に対する相 対密度をプロットした焼結ダイアグラムを示す.初期粒径が 微細であるほど,粒界拡散機構が律速する領域が拡大する.

### $3 \cdot 1 \cdot 2$ HIP

同様の解析が HIP 焼結についても行われている. HIP 焼 結において与えられた温度, 圧力等の条件下で最も早い緻密 化速度を与える緻密化機構を図示したものが HIP ダイアグ ラムと呼ばれるものである. Arzt らはランダムに充填され た同一寸法を有する複数の球形粒子の緻密化挙動についての 解析を試みた<sup>(3)-(5)</sup>. 焼結過程を相対密度  $\rho$  が0.9未満(initial stage) と0.9以上(final stage) とに分け,各粒子に接触する隣 接粒子の数と接触面積の近似解から,外部からのガス圧に起 因する粒子間に働く焼結の駆動力(有効圧力,2.4節参照)を 求め,各緻密化機構における緻密化速度が下記のように導か れた<sup>(5)</sup>. そして一定温度における相対密度と圧力の関係図, あるいは一定圧力下での相対密度と温度の関係図において, 最も早い緻密化速度を与える焼結機構とその条件を示した.

### (1) 塑性変形

粉末成形体が塑性変形を起こすのに十分な応力が印加されれば、緻密化は即座に起こり、時間依存性のある緻密化はその後に起こる、塑性変形によって生じる相対密度 *p*<sub>yield</sub> は

$$\rho_{\text{yield}} = \left(\frac{(1 - \rho_0)P}{1.3\sigma_{\text{y}}} + \rho_0^3\right)^{1/3} \quad (\rho < 0.9) \tag{4}$$

ただし $\rho_0$ は粉末成形体の初期密度,Pは外部からの印加応力, $\sigma_y$ は降伏応力である.さらに十分大きな応力が印加された場合,塑性変形のみで相対密度が0.9を超える.この場合は

$$\rho_{\text{yield}} = 1 - \exp\left(\frac{-3P}{2\sigma_{\text{y}}}\right) \quad (\rho \ge 0.9) \tag{5}$$

と与えられる.

(2) 拡散機構

粒界および粒内拡散による物質輸送で起こる緻密化速度は 以下の式で近似的に与えられる.

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = \frac{43(1-\rho_0)^2}{(\rho-\rho_0)^2} \frac{(\delta D_{\mathrm{gb}} + \rho D_{\mathrm{v}})}{kTG^3} \,\Omega P \quad (\rho < 0.9) \tag{6}$$

ただし  $\delta D_{gb}$  は粒界幅と粒界拡散係数の積, $D_v$  は体拡散係数, G は粒子径, $\Omega$  は原子体積である.また後期過程では

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = 54 \frac{\Omega \left(\delta D_{\rm gb} + r D_{\rm v}\right)}{k T G^3} 5 \sqrt{1 - \rho} P \quad (\rho \ge 0.9) \tag{7}$$

ここで r は残留ポアの半径である.

(3) べき乗則クリープ

高温高圧下では、クリープ変形(時間と共に進行する塑性 変形)の緻密化への寄与も考慮する必要がある.材料内部の 応力勾配を駆動力とした原子拡散により塑性変形が進行する 拡散クリープ,また転位の活動が関わるべき乗則クリープ (転位クリープ)が起こる場合の緻密化速度式が構築されてい る<sup>(3)-(5)</sup>.

初期過程

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = 5.3 \,(\rho^2 \rho_0)^{1/3} \frac{x}{G} \left(\frac{\dot{\epsilon}_0}{\sigma_0^n}\right) \left(\frac{P_{\mathrm{eff}}}{3}\right)^n \quad (\rho < 0.9) \tag{8}$$

ただし*x*は粒子間ネック径,  $P_{\text{eff}}$ は粒子間ネック部に働く有効圧縮応力(= $P(1-\rho_0)/(\rho^2(\rho-\rho_0))$ ), またべき乗則クリープにおけるひずみ速度  $\dot{\epsilon}$  と応力  $\sigma$  の関係(構成方程式)は  $\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}_0 (\sigma/\sigma_0)^n (\dot{\epsilon}_0, \sigma_0)$ は材料定数, *n* は応力指数)で与えられる. 後期過程

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = \frac{3}{2} \left(\frac{\dot{\epsilon}_0}{\sigma_0^n}\right) \frac{\rho (1-\rho)}{1-(1-\rho)^{1/n} n} \left(\frac{3}{2n}P\right)^n \quad (\rho \ge 0.9) \tag{9}$$

(4) 拡散クリープ

初期過程

 $\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = 24.9 \frac{\Omega}{kTG^2} (\rho^2 \rho_0)^{1/3} \frac{x}{G} \left( D_{\mathrm{v}} + \frac{\pi \delta D_{\mathrm{gb}}}{G} \right) P_{\mathrm{eff}} \quad (\rho < 0.9) \quad (10)$ 後期過程

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = 31.5 \frac{\Omega}{kTG^2} (1-\rho) \left( D_{\mathrm{v}} + \frac{\pi \delta D_{\mathrm{gb}}}{G} \right) P \quad (\rho \ge 0.9) \tag{11}$$

こうして描かれた  $Al_2O_3$ の HIP ダイアグラムの一例<sup>(5)</sup>を図 3.3に示す.図3.3(a)では  $Al_2O_3$ の融点  $T_m$ によって規格化 された規格化温度を横軸に、相対密度を縦軸に示して到達相 対密度と緻密化の律速機構を示している.ここで原料粉末の 平均粒径は2.5  $\mu$ m, HIP 圧力は100 MPa を仮定している.

図中には Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粉末(純度99.5%以上)における実験データが 併せてプロットされている. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>においては広い HIP 条 件で粒界拡散機構が支配的な緻密化機構になっている. 図中 の灰色の曲線は保持時間一定で与えた温度に対する到達相対 密度を示している. 高温もしくは高密度領域において、緻密 化に要する温度が急激に上昇しているのは、粒成長ならびに 残留ポアが粒界から分離して粒内に取り残される影響による ものである.実験データと計算結果との差は無視できるもの ではないが、それでも比較的良い近似値を与えると見て良い だろう. 炉内温度が0.65Tm を超えると緻密化に要する時間 が急激に短縮され、炉内温度を30℃上昇させると所与の密 度に達するのに要する時間を半分にすることができる.この 急峻な変化はセラミックスにおける拡散係数の温度依存性 (活性化エネルギー)が一般的な金属材料と比べて大きいこと に起因している.一方,粒成長の効果が無視できない高密度 領域では、緻密化は顕著に遅くなり、温度上昇による緻密化 促進効果は減少する.図3.3(a)は、完全緻密化を達成するた



図3.3 初期粒径2.5 µm の Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> における HIP ダイア グラムの例(5).(a)加圧応力100 MPa下で,融 点 T<sub>m</sub>によって規格化された規格化温度に対す る,到達相対密度とその律速機構.図中の灰色 の曲線は,炉温を記載された時間だけ保持した 場合の到達相対密度を示す.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>においては 広い条件範囲で緻密化の律速機構は粒界拡散機 構である.(b)温度1300℃において,印加圧力 に対して到達する相対密度と律速機構を示す. 図中の灰色の曲線は,記載された時間だけ圧力 を保持した場合に到達する相対密度を示す.

めには1500℃の温度が必要であることを示しているが、も し粒成長が抑制されれば、温度1300℃でも短時間で完全緻 密化するはずである.

図3.3(b)は,1300℃の一定温度における Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(初期粒径 2.5 μm)の HIP ダイアグラム(与えられた印加圧力に対する 到達相対密度と律速機構)を示す<sup>(5)</sup>.図中の灰色の曲線は記 載された時間だけHIP圧力を印加した場合の到達相対密度を 示している.緻密化速度に対する圧力上昇の効果は比較的小 さく,特定の相対密度に達するのに必要な時間を半分にする には,圧力を2倍にする必要がある.また,ここでも高密 度領域での粒成長に伴う緻密化速度の急激な減少が顕著であ り,現実的な圧力で HIP 処理するときに得られる最大密度 を抑制することが分かる.支配的なメカニズムは拡散である ため,緻密化速度は粒子径の微細化によって増加させ得る が,現実的に到達できる最大相対密度は粒成長挙動に強く依 存することが予想される.

### 3·2 統一速度式

実際の焼結緻密化プロセスにおいては多くの場合,材料は 室温から焼結温度までの昇温を経るものであり,昇温過程に おいても緻密化なり粒成長は進行する.一方で,焼結に伴う 収縮は早ければ良いというものではなく,焼結後に不均一な ひずみや亀裂を生じさせないために収縮を制御することが望 ましい.そこで,実際の焼結プロセスにおける緻密化挙動を 議論するとき,焼結の各段階を個々に解析するのではなく, 焼結プロセス全体を記述しようとするモデルが多数提案され てきた.

焼結の初期から後期に亘る全体的な速度式の構築例として は、例えば Wang と Raj による一般焼結式が知られる<sup>(6)</sup>. 彼らによれば、焼結速度は粒径と拡散係数に依存し、次のよ うに記述される.

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = \frac{Af(\rho)}{TG^{\mathrm{p}}} \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right) \tag{12}$$

ここでρは材料の相対密度, A は材料定数, f(ρ)は相対密度 の任意の関数, G は粒径, p は粒径指数(体拡散律速なら p = 3, 粒界拡散律速なら p=4), Q は見かけ上の活性化エネ ルギーである.ただし実際に焼結挙動を記述するためには, f(ρ)と焼結中の粒成長の影響を決定すること必要がある.そ の緻密化速度は見掛け上の活性化エネルギーによって特徴づ けられるが,その活性化エネルギーの解釈は容易ではない. Chu ら<sup>(7)</sup>は,粒成長と緻密化の両方を勘案して,焼結の駆 動力,応力増大係数,および平均ポア間隔を用いて一定の昇 温速度の下での焼結速度式を導いた.この記述では,微細構 造の幾何学的形状についてはモデルを特定せず,速度式中に パラメータとして含め,その値は実験的に決定するものとし た.

さらに、より一般的な焼結挙動を記述する試みとして、焼 結中の微細組織変化を近似的に取り扱うことで、昇温履歴に 依らない統一的な緻密化曲線、すなわちマスターシンタリン グカーブの記述が提唱された<sup>(8)</sup>.マスターシンタリングカー ブによる統一的な緻密化曲線の記述は、等温熱処理もしくは  一定昇温速度下でのさまざまな系(Ni, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZnO などの 単相材料および Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-ZrO<sub>2</sub> などのコンポジッ
 ト)において試みられ、与えられた昇温条件下での焼結緻密
 化過程の予測に成功している<sup>(8)</sup>.マスターシンタリングカー
 ブについては例えば文献(9)などに詳しく解説されている
 が、以下その概略を述べる.

焼結機構を粒界および体拡散のみであると仮定した場合, 焼結途上の各瞬間における粉末成形体の収縮率 dL/dt は次 のように書ける.

$$-\frac{\mathrm{d}L}{L\mathrm{d}t} = \frac{\gamma\Omega}{kT} \left( \frac{\Gamma_{\mathrm{v}}D_{\mathrm{v}}}{G^3} + \frac{\Gamma_{\mathrm{gb}}\delta D_{\mathrm{gb}}}{G^4} \right) \tag{13}$$

ここで $\gamma$ は表面エネルギー, $\Omega$ は原子体積,kはボルツマン 係数,Tは絶対温度,Gは平均粒径, $D_v \ge D_{gb}$ はそれぞれ 体拡散および粒界拡散の拡散係数, $\delta$ は粒界幅である.また  $\Gamma$ は各焼結機構(体拡散:v,粒界拡散:gb)の駆動力,拡散 距離,その他幾何学的条件で決まる定数である.経験的にこ の値は,表面拡散機構や顕著な粒成長が認められない限り相 対密度に依存し,昇温過程(熱履歴)に依存しないという点に 着目し,下記の如く相対密度・粒径項と温度・時間項とを分 離できるものとした.収縮率を相対密度 $\rho$ に変換し, $G \ge \Gamma$ が $\rho$ のみの関数であると仮定すると次のように書き直せて,

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{3\rho\mathrm{d}t} = \frac{\gamma\Omega(\Gamma(\rho))D_0}{kT(G(\rho))^p} \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$
(14)

ここでQは見掛け上の活性化エネルギー,体拡散では $D_0$ は $D_v$ の前指数項でp=3,粒界拡散では $D_0$ は $\delta$ と $D_{gb}$ の前指数項との積でp=4となる.これを積分すれば

$$\sum_{\rho_0}^{\rho} \frac{(G(\rho))^{\mathrm{p}}}{3\rho\Gamma(\rho)} \mathrm{d}\rho = \int_0^t \frac{\gamma\Omega D_0}{kT} \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right) \mathrm{d}t \tag{15}$$

これをさらに整理すると,相対密度,微細組織と材料定数の みからなる項

$$\Phi(\rho) \equiv \frac{k}{\gamma \Omega D_0} \int_{\rho_0}^{\rho} \frac{(G(\rho))^n}{3\rho \Gamma(\rho)} \mathrm{d}\rho$$
(16)

および見掛けの活性化エネルギーと温度の時間変化のみに依 存する項

$$\Theta(t, T(t)) \equiv \int_0^t \frac{1}{T} \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right) dt$$
(17)

とに分離することができ,

(18)

と書ける.式(18)の左辺をマスターシンタリングカーブと 呼ぶ.

 $\Phi(\boldsymbol{\rho}) = \boldsymbol{\Theta}(t, T(t))$ 

実際にマスターシンタリングカーブを描くためには、実験 的に幾つかの昇温速度での焼結緻密化曲線を取得し、相対密 度を $\Theta(t,T(t))$ に対してプロットする<sup>(8)(9)</sup>.見かけ上の活性 化エネルギーQの値を変化させて各昇温速度での実験デー タから同じ相対密度での $\Theta(t,T(t))$ の平均二乗誤差を計算 し、平均二乗誤差が極小を取るQの値を見つける(図3.4 (a)).このとき、異なる昇温速度で得られた緻密化曲線は、 単一のマスターシンタリングカーブに収束することになる. 一旦マスターシンタリングカーブが得られれば、任意の焼結 曲線を得ることができる.SuとJohnson が示した例を図3.4 (b)に示す<sup>(8)</sup>.試料をAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>とし、昇温速度を8,15,30, 45℃/min として1500℃まで昇温した場合の緻密化曲線(温



図3.4 (a)マスターシンタリングカーブの導出の流れ と、(b)実際に Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>においてマスターシンタリ ングカーブに基づいて得られた焼結収縮曲線の 予測と実験結果<sup>(8)</sup>.

度に対する相対密度)を実験的に得た.このデータを基に, 見かけの活性化エネルギーを440 kJ/mol として log  $\Theta(t, t)$ T(t))に対する相対密度を描くと、いずれの焼結緻密化曲線 も単一の曲線、すなわちマスターシンタリングカーブに収束 した. 図3.4(b)に、マスターシンタリングカーブによって予 測された,昇温速度100℃/min,焼結温度1185℃および 1315℃における緻密化曲線の予測値(図中の実線)と、実験 値との比較を示す。特に焼結温度1315℃において実験と予 測値が良く一致していることが分かる.マスターシンタリン グカーブに基づいた解析は、見掛け上の活性化エネルギーな ど物理的意味が必ずしも明確でない部分も存在するが、工業 的に適切な昇温スケジュールを得る上では有益な情報が得ら れると期待される. すなわち, 製品の焼結緻密化過程におい て、焼結体の不均一なひずみや割れによる歩留まり低下・特 性劣化を避けるための適切な昇温過程を経験則に依らず定量 的に導出することが可能になる<sup>(9)</sup>.

## 3.3 焼結現象のシミュレーション

### 3・3・1 複雑な粉末成形体における焼結

ここまで,同じ化学組成や表面・粒界エネルギーを有する

粒子からなる粉末成形体における焼結を扱ってきた.しか し、この単純な系でも粒子の形状やサイズの分布は焼結挙動 に大きな影響を及ぼす. さらに圧粉成形体の形状や粉末充填 の不均一性なども、実際の焼結緻密化挙動を支配する重要な 要因となる.1980年代以降, 焼結体の機械特性を向上させ る目的で、第二相粒子やウィスカー、繊維を添加したセラミ ックス複合材が製造されるようになった. また, コンデンサ ー等の電子部品を構成する機能性セラミックスは、多くの場 合薄膜状あるいは層状の成形体を焼結することになる. こう した場合、粉末成形体内部の充填密度や緻密化速度は得てし て不均一であり、さらに緻密化に伴う収縮が異相界面で拘束 されることから、実用に供する製品の焼結において焼結技術 の向上が要求された. 原料粉末の充填の不均一性や、複数の 相から成形体が構成される場合の焼結緻密化について、具体 的な事例(10)を幾つか挙げてみよう.プレス成形で得られる 成形体には、一般的に金型と粉末との摩擦や、金型形状に由 来して粉末の充填密度に不均一が生じる.粉末の充填に不均 一があると、緻密化が完了するまでに要する緻密化量が成形 体内部で異なるため、初期充填密度が高い箇所は圧縮応力下 に置かれ、充填密度の低い箇所は逆に引張り応力下に置かれ ることになる(図3.5(a)). こうした内部応力が生じる場合, 焼結後の製品全体が均一に収縮せず、不均一なひずみや亀裂 が発生する可能性がある.粉末成形体の内部に粉末粒子の凝 集体が含まれたり、第二相粒子が混合されている場合には、 粉末成形体のマトリックスは凝集体や第二相粒子の周囲で緻 密化する必要がある(図3.5(b)). 凝集体や第二相粒子に比べ てマトリックスの方が緻密化速度が速い場合、第二相は圧縮 応力下に置かれ、マトリックス内部は逆に引張り応力を受け ることになる.このことも、焼結後のひずみや割れにつなが る可能性がある.また,薄膜状の粉末成形体を緻密な基板上 で焼結する場合にも、同様の状況が発生する(図3.5(c)). 複 数の結晶相から成る層状構造の粉末成形体において、各層の 緻密化速度が異なる場合には、各層は互いに拘束され、やは り内部応力が発生する(図3.5(d)). こうしたことから, 例え ば図3.5(e)に示すような積層材料においては、焼結緻密化挙 動だけでなく、熱膨張係数差に由来する昇温・降温時の熱応 力に起因して内部応力が発生し、部材のゆがみや層間剥離や 層間·層内亀裂が起こる<sup>(11)</sup>.

次に粉末成形体の形状要因について考えてみよう.図3.6 (a)のように、単純な円板状の粉末成形体を焼結する場合、 もし粉末の粒度や充填が十分均一であれば、緻密化と共に成 形体全体は円板の中央(重心)に向かって収縮する.これに対 し、円板を二つ繋げたダンベル状の粉末成形体を焼結する場 合、均一に緻密化するならば図3.6(b)のように、やはり重心 に向かって収縮するはずである.だが粉末成形体と炉床との 間に摩擦が働けば、左右の円板部が中央の接続部を引張る形 になるため、円板の接続部に引張り応力が働く可能性があ る.こうした形状の粉末成形体は焼結緻密化後に中央の接続 部に亀裂が入りそうに思われる.このように、粉末成形体の わずかな形状変化で、均一な焼結緻密化が困難になり得るこ とが予想される.

以上のように、原料粉末の粒径分布や、粉末の充填の不均





ーさ、また粉末成形体の形状に起因する局所的な収縮量の違いは製品の焼結緻密化に大きな影響を与えるものであり、こうした不均一さが生み出す粉末成形体内部の応力分布が焼結後のひずみや割れの原因と考えられている<sup>(12)</sup>.

### 3·3·2 焼結応力

こうした経緯から,焼結体内部での緻密化速度の不均一分 布に由来する焼結中の内部応力の発生に関心が寄せられるよ うになった.3・1節でみたような,実際的な系の緻密化挙 動を定式化するために,80年代後半から多孔体の変形やひ ずみ不整合に起因する応力・ひずみを予測するための連続体 力学モデルの導入が図られた.焼結の駆動力は前回(2・3 節)述べたように応力として捉えることができる.粉末成形 体は高温下で次第に収縮していくことから,全体としては粉 末間に自ずと圧縮応力が働いていると考えることができる. 焼結の駆動力を仮想的な外部応力,いわゆる焼結応力として 捉えれば,巨視的な焼結収縮は連続体力学に基づく高温変形



図3.6 (a)単純な円板状の粉末成形体を焼結する場合. もし粉末の粒度や充填が十分均一であれば,緻 密化と共に成形体全体は円板の中央(重心)に向 かって収縮することが予想される.(b)円板を二 つ繋げたダンベル状の粉末成形体を焼結する場 合の焼結緻密化の予想.

として扱うことができ、ひずみ速度は外部から加えられた機械的応力と緻密化の駆動力に対する線形応答として表される<sup>(13)(14)</sup>ことから、収縮速度を与える有効粘性係数を定義できる<sup>(15)</sup>.また3·3·1節で見たような、成形体内部の不均一性に起因する内部応力の発生を考慮し、連続体理論に基づく有限要素法シミュレーションを行えば、焼結中の内部応力や製品の変形を予測できる<sup>(13)-(15)</sup>.

焼結応力は,粉末成形体なり焼結途上の多孔体の収縮を生 じさせない,内部の表面張力と釣り合う静水圧応力として定 義される.それゆえ次式が成り立てば,多孔体は平衡状態に あることになる<sup>(16)</sup>.

$$\sigma_{\rm s} \Delta V = \gamma_{\rm gb} \Delta A_{\rm gb} + \gamma_{\rm s} \Delta A_{\rm s} \tag{19}$$

ただし $\sigma_s$ は焼結応力, $\Delta V$ はポア(空隙)の体積変化,他は 第2回式(1)と同様である.これを書き直して,

$$\sigma_{\rm s} = \gamma_{\rm gb} \frac{\partial A_{\rm gb}}{\partial V} + \gamma_{\rm s} \frac{\partial A_{\rm s}}{\partial V} \tag{20}$$

となる.または、個々の粒子表面iに働く力 $F_i$ 、体積変化 dVに対応する粒子表面iの垂直方向の変位を $du_i$ として

$$\boldsymbol{\sigma}_{\rm s} \,\mathrm{d} \, V = \sum F_i \mathrm{d} \, \boldsymbol{u}_i \tag{21}$$

とも書ける.

粉末成形体の焼結特性は、連続体解析を用いてひずみ速度 と応力の関係(構成モデル)で例えば次式で与えられ る<sup>(17)-(20)</sup>.

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}_{ij} = \frac{1+\nu}{E} \boldsymbol{\sigma}'_{ij} + \boldsymbol{\delta}_{ij} \frac{1-2\nu}{E} (\boldsymbol{\sigma}_{\rm m} + \boldsymbol{\sigma}_{\rm s})$$
(22)

ここで( $\dot{\epsilon}_{ij}$ )はひずみ速度(i, j = x, y, z),  $\nu$ は粘性ポアソン比,

Eは縦粘性係数, $\delta_{ii}$ はクロネッカーのデルタ, $\sigma'_{ii}$ は偏差応 力, $\sigma_{\rm m}$ は静水圧応力, $\sigma_{\rm s}$ は焼結応力である. $v, E, \sigma_{\rm s}$ は相対 密度の関数となり,成形体の微細構造変化が考慮されなけれ ばならない. また $E \ge \sigma_s$ はせん断粘性係数や表面張力, 温 度にも依存する.粉末成形体を描写する様々なモデルが提案 されているが、いずれにせよ精度の高い焼結挙動ないし応力 解析を行うには、ν, E, σ<sub>s</sub>に代表される焼結特性の実測が必 要となる(20). 焼結特性を計測する手法としては,一軸応力 下での粉末成形体の半径方向と軸方向のひずみに基づく解析 (焼結鍛造)<sup>(21)</sup>や,焼結体の収縮時に働く引張り荷重を直接 的に計測する手法(ゼロクリープ法に類似)(22)などが知られ ている.連続体レベルの取り扱いは比較的単純形状の焼結部 材のゆがみやクラック発生の予測・解析に適用されている. 例えば Shinagawa らは、金属/セラミックス傾斜機能材料の 積層構造に対し、平板の曲げ理論を用いて系統的な応力解析 を行うことで、粒度や層厚の調整による面内方向応力の最適 化を理論的に図り、しばしばセラミックス層にクラックを生 じる当該材料の焼結割れを抑制させることに成功した<sup>(23)</sup>. 焼結の駆動力を定式化するにあたって焼結応力を用いること は、加圧焼結や、成形体内外の機械的な応力が生じるような 焼結過程の解析に有効であるとされている<sup>(17)(24)(25)</sup>.

この他,フェイズフィールド法<sup>(26)</sup>やモンテカルロ法の導 入<sup>(27)</sup>, さらに有限要素法とこれらの手法を組み合わせ, 焼 結中の巨視的変形と微視的収縮挙動を相互に参照させ連成し た計算により、実際の製品形状の粉末成形体における微細組 織形成と巨視的な収縮挙動についての予測が行われてい る<sup>(28)</sup>.近年,放射光X線マイクロトモグラフィー技術の進 展により、焼結中の複雑な三次元気孔構造変化を直接観察で きるようになった<sup>(29)(30)</sup>.こうした測定手法の向上により粉 末成形体の微構造に関する知見が充実し、コンピュータ能力 の向上と相まってより現実に即した焼結シミュレーションが 可能になるであろう.一方,セラミックス粉末およびスラリ ーの3Dプリンティング技術など、成形体はより高度化・複 雑化すると思われる. 焼結シミュレーションによる緻密化挙 動の予測や、計算手法に基づく焼結プロセスの最適化は、今 後さらに重要性を増すであろう.

### 文 献

- (1) M. F. Ashby: Acta Metall., 22(1974), 275–289.
- (2) S.-J. L. Kang and Y.-I. Jung: Acta Mater., 52(2004), 4573-4578.
- (3) E. Arzt: Acta Metall., 30(1982), 1883-1890.
- (4) E. Arzt, M. F. Ashby and K. E. Easterling: Metall. Trans. A, **14**(1983), 211-221.
- (5) A. S. Helle, K. E. Easterling and M. F. Ashby: Acta Metall., 33 (1985), 2163-2174.
- (6) J. Wang and R. Raj: J. Am. Ceram. Soc., 73(1990), 1172-1175.
- (7) M.-Y. Chu, M. N. Rahaman, L. C. De Jonghe and R. J. Brook: J. Am. Ceram. Soc., 74(1991), 1217-1225.
- (8) H. Su and D. L. Johnson: J. Am. Ceram. Soc., 79(1996), 3211-3217.
- (9) 多々見純一:セラミックス, 48(2013), 22-27.
- (10) D. J. Green, O. Guillon and J. Rödel: J. Eur. Ceram. Soc., 28 (2008), 1451-1466.
- (11) P. Z. Cai, D. J. Green and G. L. Messing: J. Am. Ceram. Soc., 80(1997), 1929-1939.
- (12) A. G. Evans: J. Am. Ceram. Soc., 65 (1982), 497-501.
- (13) R. K. Bordia and G. W. Scherer: Acta Metall., 36 (1988), 2393-2397.
- (14) H. Riedel, H. Zipse and J. Svoboda: Acta Metall. Mater., 42 (1994), 445-452.
- (15) O. Guillon, J. Rödel and R. K. Bordia: J. Am. Ceram. Soc., 90 (2007), 1637-1640.
- (16) J. Svoboda, H. Riedel and H. Zipse: Acta Metall. Mater., 42 (1994), 435-443.
- (17) E. A. Olevsky: Mater. Sci. Eng. R, 23(1998), 41-100.
- (18) R. K. Bordia and G. W. Scherer: Acta Metall., 36 (1988), 2393-2397.
- (19) T. Kraft and H. Riedel: J. Eur. Ceram. Soc., 24(2004), 345-361.
- (20) 品川一成:粉体および粉末冶金,56(2009),592-597.
- (21) R. Zuo, E. Aulbach and J. Rödel: Acta Mater., 51 (2003), 4563-4574.
- (22) T. Ikegami, N. Iyi and I. Sakaguchi: Ceram. Int., 35(2009), 3185 - 3194.
- (23)K. Shinagawa and Y. Hirashima: Mater. Sci. Forum, 492-493 (2005), 477-482.
- (24) M. N. Rahaman: Ceramic Processing and Sintering, Second edition, Taylor & Francis, Boca Raton (2003), 470-539.
- (25) 若井史博,赤津 隆, 篠田 豊: セラミックス, 49(2014), 49 - 86.
- (26) Y. U. Wang: Acta Mater., 54(2006), 953-961.
- (27) C. G. Cardona, V. Tikare, B. R. Patterson and E. Olevsky: J. Am. Ceram. Soc., 95 (2012), 2372-2382.
- (28) H. Matsubara: J. Ceram. Soc. Japan, 113(2005), 263-268.
- (29) D. Bernard, D. Gendron, J-M. Heintz, S. Bordère and J. Etourneau: Acta Mater., 53(2005), 121-128.
- (30) F. Wakai and O. Guillon: Acta Mater., 66 (2014), 54-62.

に関する研究に従事.



1997年 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了 2001年 博士号取得(論文博士(工学),東京大学) 1999年~2004年 東京大学大学院新領域創成科学研 究科·助手 2004年~2019年 物質・材料研究機構・研究員 2019年~現職 専門分野:セラミック材料学

\*\*\*\*\*

吉田英弘

◎構造・機能セラミックスの微細組織制御と特性向上 \*\*\*\*\*